## СТРУКТУРА ЭВТЕКТИЧЕСКОГО СИЛУМИНА, ОБРАБОТАННОГО ИНТЕНСИВНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ

## Иванов Ю.Ф., Петрикова Е.А., Толкачев О.С, Тересов А.Д.

Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск, Россия, E-mail: yufi55@mail.ru

Структура силуминов и, прежде всего, форма и размеры зерен алюминия и кристаллов кремния в эвтектическом сплаве, завися от условий плавки и кристаллизации, оказывают существенное влияние на свойства материала [1]. Следовательно, управление структурой силуминов является одной из задач технологии их получения и последующего модифицирования. В работе [2] показано, что облучение силумина эвтектического состава высокоинтенсивным импульсным электронным пучком в режиме плавления приводит к формированию поверхностного слоя, микротвердость которого превышает микротвердость исходного материала более чем в 2 раза. Одновременно с этим облучение силумина высокоинтенсивным электронным пучком сопровождается увеличением предела прочности материала на изгиб в  $\approx$ 1,2 раза и на растяжение в  $\approx$ 1,4 раза. Предел пластичности увеличивается в  $\approx$ 1,2 раза при испытаниях на изгиб и в  $\approx$ 1,8 раза при испытаниях на растяжение. Очевидно, что выявленное в [2] изменение свойств силумина, облученного интенсивным импульсным электронным пучком, обусловлено модифицированием его структурно-фазового состояния.

Целью настоящей работы является исследование структурно-фазового состояния силумина эвтектического состава, подвергнутого поверхностной обработки интенсивным импульсным электронным пучком.

В качестве материала исследования использовали силумин марки АК12 (11.1 Si, 0.58 Mg, 2.19 Cu, 0.92 Ni, 0.25 Fe, 0.029 Mn, 0.047 Ti, 0.005 Cr, ост. Al (вес. %)). Образцы имели форму диска диаметром 15 мм и толщиной 5 мм. Облучение поверхности силумина осуществляли интенсивным импульсным электронным пучком на установке «СОЛО» [3] при следующих параметрах: энергия электронов 15 кэВ, плотность энергии пучка электронов 20 Дж/см², длительность импульса пучка электронов 150 мкс, количество импульсов 3, частота следования импульсов 0,3 с¹. Исследования фазового состава силумина осуществляли методами рентгенофазового анализа (дифрактометр XRD-7000s, Shimadzu, Япония). Исследование элементного и фазового состава, дефектной субструктуры силумина осуществляли методами сканирующей (прибор Philips SEM 515, оснащенный микроанализатором EDAX ECON IV) и просвечивающей электронной дифракционной микроскопии (прибор JEM-2100F, JEOL, Япония). Фольги (объект исследования материала методами просвечивающей электронной микроскопии) изготавливали методами ионного утонения тонких (100 мкм) пластинок на приборе Ion Slicer EM 09100IS.

На рисунке 1 и в таблице 1 представлены результаты микрорентгеноспектрального анализа силумина перед облучением электронным пучком (исходное состояние), из анализа которых следует, что легирующие элементы сплава распределены в материале весьма неоднородно, формируя различные соединения, различающиеся не только составом, но и морфологией.

Фазовый состав силумина в исходном состоянии, выявленный методами рентгенофазового анализа, представлен твердым раствором на основе алюминия (86,7 отн. %), кремния (13.3 отн. %),

Морфологию и элементный состав силумина в исходном состоянии анализировали методами просвечивающей электронной микроскопии, используя приставку для энергодисперсионного микрорентгеноспектрального анализа (метод СТЕМ). Результаты выполненных исследований приведены на рисунке 2 и рисуке 3.

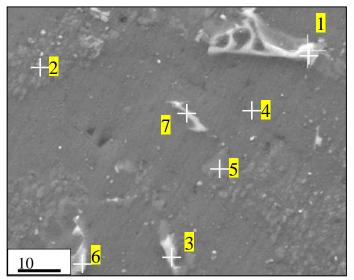


Рисунок 1 — Электронно-микроскопическое изображение структуры силумина в исходном состоянии; указаны области, в которых был выполнен микрорентгеноспектральный анализ элементного состава материала. Сканирующая электронная микроскопия.

Таблица 1 — Результаты микрорентгеноспектрального анализа участка поверхности силумина AK12, электронно-микроскопическое изображение которого представлено на рисунке 1

Область	Элемент (остальное Al, вес. %)				
	Si	Ni	Cu	Fe	Mn
1	0,6	13,5	13,3	0,0	0,0
2	8,7	0,3	2,2	0,0	0,0
3	1,7	11,8	14,0	0,0	0,0
4	0,5	0,2	1,3	0,0	0,0
5	22,5	1,1	1,6	1,2	0,0
6	1,1	14,8	15,8	0,5	0,0
7	2,3	17,2	5,2	2,7	0,6

На рисунке 2 приведены результаты исследования распределения атомов кремния и магния в силумине АК12, выявленные методами СТЕМ.

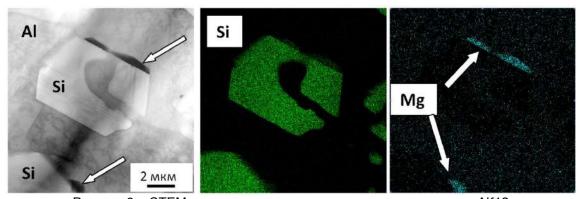


Рисунок 2 – СТЕМ анализ элементного состава силумина марки АК12

Отчетливо видно (рис. 2), что магний располагается в вдоль границы раздела включения кремния и алюминия. Другие варианты распределения атомов кремния, магния, меди и никеля, выявленные методами микрорентгеноспектрального анализа (метод СТЕМ), приведены на рисунке 3.

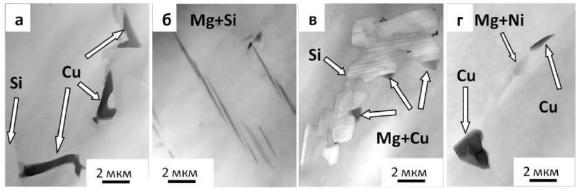


Рисунок 3 – СТЕМ анализ элементного состава силумина марки АК12

Таким образом, методами СЭМ и СТЕМ показано, что присутствующие в силумине элементы распределены неоднородно, формируя различные фазы.

Облучение поверхности силумина интенсивным импульсным электронным пучком в режиме плавления и последующего высокоскоростного охлаждения приводит к формированию поверхностного слоя толщиной до 50 мкм, имеющего структуру ячеистой кристаллизации (рис. 4). Объем ячеек сформирован твердым раствором на основе алюминия (рис. 4, в), разделяющие ячейки прослойки — кремнием (рис. 4, б). Включений интерметаллидных фаз в данном слое не обнаружено. Следовательно, облучение интенсивным импульсным электронным пучком приводит к гомогенизации поверхностного слоя силумина.

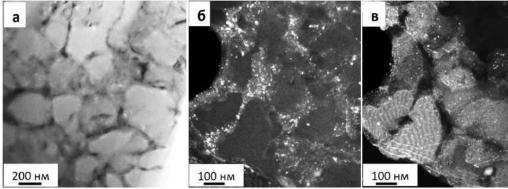


Рисунок 4 — Электронно-микроскопическое изображение структуры ячеистой кристаллизации силумина марки АК12; а — светлое поле; б, в — темные поля, полученные в рефлексах [220]Si и [111]AI.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект №16-58-00075-Бел\_а).

## Список литературы:

- 1. Белов Н.А. Фазовый состав и структура силуминов / Н.А. Белов, С.В. Савченко, А.В. Хван. М.: МИСИС, 2008. 282 с.
- 2. Электронно-ионно-плазменная модификация поверхности цветных металлов и сплавов /под общ. ред. Н.Н.Коваля и Ю.Ф. Иванова. –Томск: Изд-во НТЛ, 2016.–312 с.
- 3. Коваль Н.Н., Иванов Ю.Ф. Наноструктурирование поверхности металлокерамических и керамических материалов при импульсной электроннопучковой обработке // Известия вузов. Физика. 2008. №5. С. 60-70.